

垂直爐管注意事項

- 01、欲操作使用爐管之博士班研究生需通過機台負責人的訓練方可使用。
- 02、欲考核爐管者，須先考核過
(1)Wet-Bench (2)N&K(3)Ellisopmeter。
- 03、使用爐管需確實填寫操作紀錄簿。
 - a) 開始執行 Recipe 後，便該立刻填寫，填寫後才可離開。
 - b) 填寫時務求字體工整，一定要留聯絡電話。
 - c) 若有沉積薄膜，一定要填寫沉積厚度。
- 04、Dry Oxide 沉積膜厚凡小於 100Å 者，一律用橢圓測厚儀量測，大於 100Å 者橢圓測厚儀或是 N&K 均可。
Poly-Si 與 α -Si 則全部用 N&K 測。
- 05、合格之使用人員若將機台使用卡外借他人使用，將取消使用資格兩個月。
- 06、嚴禁進爐管之晶片：
 - a) 未經 TSRI class10 Wet-Bench 清洗 (新的晶片亦須清洗)
 - b) 未去光阻
 - c) 破片或缺角
 - d) 含金屬(如經後段 PECVD，CMP.....製程之晶片)
 - e) 含 III-V 族
 - f) 未經許可之特殊晶片 (表面有異物也算)
 - g) 未經旋乾之晶片
 - h) Run 過非 TSRI 前段機台(Run 過交大奈米中心機台後，也不能再進爐管)
若有問題，請詢問機台負責人，若違規經查獲，處以最嚴厲之處分。
- 08、無論何時，爐管以 TSRI 的 RUN 為最優先，有問題直接聯絡機台負責人。
- 09、Run 貨預約時間請與操作員確認，如有疑問請聯絡製程整合組。